(19) **日本国特許庁(JP)**

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-146297 (P2004-146297A)

(43) 公開日 平成16年5月20日(2004.5.20)

(51) Int.C1.7

 $\mathbf{F} \mathbf{I}$

テーマコード (参考)

HO 1 M 10/38 HO 1 M 10/36 HO1M 10/38 HO1M 10/36 5H029

A

審査請求 未請求 請求項の数 5 〇L (全 7 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日 特願2002-312441 (P2002-312441) 平成14年10月28日 (2002.10.28) (71) 出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(74) 代理人 100097445

弁理士 岩橋 文雄

(74) 代理人 100103355

弁理士 坂口 智康

(74) 代理人 100109667

弁理士 内藤 浩樹

(72) 発明者 美濃 辰治

大阪府門真市大字門真1006番地 松下

電器産業株式会社内

(72) 発明者 石井 弘徳

大阪府門真市大字門真1006番地 松下

電器産業株式会社内

最終頁に続く

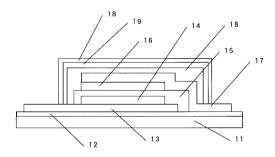
(54) 【発明の名称】固体電池

(57)【要約】

【課題】固体電池において保護膜が剥がれること、電池 容量が少なくなることが課題となっている。

【解決手段】本発明の固体電池は、発電要素と、前記発電要素を覆う酸化シリコン系膜からなる第1の保護膜18と、前記第1の保護膜を覆う第2の保護膜19と、前記第2の保護膜を覆う第3の保護膜20を備え、前記第3の保護膜20の大気に露出した表面は酸化シリコン系膜、又は酸化チタン系膜であり、かつ酸化シリコン系膜と窒化シリコン系膜の積層体層、又は酸化チタン系と窒化シリコン系膜の積層体層を少なくとも1以上有する、保護膜の剥がれがなくかつ電池容量の充放電特性が優れ、さらにサイクル劣化がない固体電池となる。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に、第1集電体、第1電極、固体電解質、第2電極、第2集電体を積層した発電要素と、保護膜とを備えた固体電池であり、前記保護膜は3層以上積層されてなり、少なくとも一層が窒化シリコン系膜であることを特徴とする固体電池。

【請求項2】

保護膜の最外層は酸化膜であることを特徴とする請求項1記載の固体電池。

【請求項3】

保護膜の膜厚は 0 . 1 μ m 以上であることを特徴とする請求項 1 または 2 記載の固体電池

10

【請求項4】

発電要素に第1の保護膜として酸化シリコン系膜を形成し、さらに第2の保護膜として窒化シリコン系膜を形成し、さらに第3の保護膜として酸化シリコン系膜を形成することを特徴とする請求項1から3いずれかに記載の固体電池。

【請求項5】

発電要素に第1の保護膜として酸化シリコン系膜を形成し、さらに第2の保護膜として窒化シリコン系膜を形成し、さらに第3の保護膜として酸化チタン系膜を形成することを特徴とする請求項1から3いずれかに記載の固体電池。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は正極、電解質、および負極が積層された固体電池に関し、特に電池の表面に形成する保護膜に関するものである。

[0 0 0 2]

【従来の技術】

電子機器の小型化、軽量化に伴い、電池についても小型化、軽量化の要望が強くなっている。最近では一気に縮小化を進めるため、固体電解質二次電池を用いた薄膜固体二次電池が注目されている。これら固体電解質二次電池の充電および放電は電池を形成する材料に含まれるイオンが担っており、その電池が置かれる外的環境に影響されることが知られている。

30

20

[0003]

例えばリチウムイオン電池の場合は充電および放電を担うのはリチウムイオンであり、水分の影響(湿気)により電池の容量劣化を生じる。このため、確実なパッケージングによって外環境からの影響を絶っている。固体電池においても同様のことが求められ、電池の表面を形成する保護膜がその役割を果たすことになる。保護膜に関しては、窒化珪素を絶縁被膜とするものが提案されている(例えば特許文献1。)。

[0004]

図3は前記特許文献1に記載された従来の固体電池を示す断面図である。図3において、基板31上に正極集電体32、正極活物質膜33、固体電解質膜34、負極活物質膜35、負極集電体36を積層した発電要素の保護膜として窒化シリコン系膜37を用いていた。これにより、その下地の発電要素を外的衝撃や水分(湿気)等から保護していた。

40

[0005]

【特許文献1】

特開 2 0 0 2 - 4 2 8 6 3 号公報

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、前記従来の構成では、窒化珪素膜には以下のような課題がある。ひとつは、窒化シリコン系膜は硬質な膜であるため、発電要素の膨張収縮等により窒化シリコン系膜の剥がれが生じる。また、窒化シリコン膜は Si-Nの未結合部を生じやすいので、充電および放電を担うリチウムイオンがトラップされて電池容量が劣化するという課題を有

していた。

[0007]

本発明は、前記従来の課題を解決するもので、膜強度に優れ、電池容量劣化の少ない固体電池を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】

前記従来の課題を解決するために、本発明の固体電池は基板上に、第1集電体、第1電極、固体電解質、第2電極、第2集電体を積層した発電要素と、保護膜とを備えた固体電池であり、前記保護膜は3層以上積層されてなり、少なくとも一層が窒化シリコン系膜である。

[0009]

さらに、保護膜の最外層は酸化膜である。

[0010]

さらに、保護膜の膜厚は 0 . 1 μ m 以上である。

[0011]

さらに、発電要素に第1の保護膜として酸化シリコン系膜を形成し、さらに第2の保護膜として窒化シリコン系膜を形成し、さらに第3の保護膜として酸化シリコン系膜を形成する。

[0012]

さらに、発電要素に第1の保護膜として酸化シリコン系膜を形成し、さらに第2の保護膜として窒化シリコン系膜を形成し、さらに第3の保護膜として酸化チタン系膜を形成する

[0013]

【発明の実施の形態】

以下本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。

[0014]

(実施の形態1)

図1は、本発明の実施の形態1における固体電池の断面図である。

[0015]

同図において、シリコン基板11上にプラズマCVD法(Chemical Vapor Deposition)によってシリコン酸化膜12を1500 形成した上に正極集電体として金属アルミ膜13を真空蒸着装置により、縦10mm、横15mmのパターンで形成し、その上にLico02の正極活物質膜14を厚み5μm、縦横8mmの64mm²でスパッタにより形成し、その上にLi2S-SiS2-Li3PO4の固体電解質膜15dを厚み5μm、縦横14mmで形成し、更にその上に、グラファイトの負極活物質膜16を厚み5μm、縦横8mmで形成し、順にレーザーアブレーション法により積層する。それらの成膜はそれぞれ、前述のサイズに空いた金属マスク(SUS304)を用いてパターニングする。更にその上に負極集電体の金属銅膜17をパターニングされた金属マスク(SUS304)を用いて、真空蒸着法で1μm、縦10mm、横15mmで形成して発電要素を構成している。その上に保護膜としてSi0218とSi3N419の上下にSi0218を設けた。

[0016]

この構成によれば、発電要素の保護膜としていずれか一層以上を窒化シリコン系膜とすることにより、電気絶縁性に優れた硬質な膜となり、その下地の発電要素は外的衝撃や水分 (湿気)から保護される。

[0017]

前記室化シリコン系膜の下地は前記発電要素を覆う酸化シリコン系膜からなる第1の保護膜を形成することで、前記発電要素に膨張収縮がある場合に対して、前記室化珪素膜の割れや剥がれを抑制することができ、更に、前記室化珪素膜はSi-Nの未結合部を生じや

10

20

30

40

すいので、充電および放電を担うイオンがトラップされて電池容量が劣化することも抑制 することができる。

[0018]

また、前記室化シリコン系膜の上に酸化シリコン系膜を形成することで、前記発電要素の保護機能が増し、特にピンホール対策が充分となり安価で信頼性の高い固体電池を提供できる。

[0019]

評価結果を(表1)に示す。

[0020]

本実施の形態にて作成した電池は、正常に充放電が行えて 3 0 0 μ A h の容量が得られた。また電池容量の充放電サイクル劣化も見られず(試験 1)、膜のピンホール発生もなく(試験 2)、充放電 2 0 0 サイクル後の保護膜のクラック発生もなかった(試験 3)。

[0021]

【表1】

保護膜構造	サンプル No.	第1保護膜	第2保護膜	第3保護膜	試験① 充放電 サイクル特性 (%)	試験② 膜ピンホール (個)	試験③ 充放電 200サイクル後 クラック発生
従来構造1	1	Si ₃ N ₄	なし	なし	85	9	有り
従来構造2	2	SiO ₂	Si ₃ N ₄	なし	98	5	無し
実施の形態1	3	SiO ₂	Si ₃ N ₄	\$iO ₂	99	0	無し
実施の形態2	4	SiO ₂	Si ₃ N ₄	TiO ₂	99	0	無し

20

30

40

50

[0022]

(実施の形態2)

図 2 は、本発明の実施の形態 2 における固体電池の断面図である。図 2 において、図 1 と同じ構成要素については同じ符合を用い、説明を省略する。

[0 0 2 3]

同図において、発電要素の上に保護膜としてSiO $_2$ 18とSi $_3$ N $_4$ 19とTiO $_2$ 20を順にスパッタにより形成したものであり、Si $_3$ N $_4$ 19の上にTiO $_2$ 20を設けた。

[0 0 2 4]

評価結果を(表1)に示す。

[0 0 2 5]

この構成によれば前述の実施の形態 1 と同様の効果を得ることができる。尚、本実施形態にて作成した電池は、正常に充放電が行えて 3 0 0 μ A h の容量が得られた。また電池容量の充放電サイクル劣化も見られず(試験 1)、膜のピンホール発生もなく(試験 2)、充放電 2 0 0 サイクル後の保護膜のクラック発生もなかった(試験 3)。

[0 0 2 6]

(実施の形態3)

実施の形態 1 および実施の形態 2 において、前記発電要素の上に積層される第一の保護膜である酸化シリコン系膜、第二の保護膜である窒化シリコン系膜、第三の保護膜である酸化チタン系膜および酸化シリコン系膜のそれぞれの膜厚を 0 . 1 μm以上で形成した。

[0 0 2 7]

この構成によれば、第一の保護膜である酸化シリコン系膜の膜厚が 0 . 1 µ m以上であるため、発電要素の充放電をになうイオンが第二の保護膜である窒化シリコン系膜にトラップされることを防止でき、また発電要素の充放電等に伴う膨張収縮も押さえ込むことができるため第二の保護膜の剥れやクラックの発生を防止できる。

[0 0 2 8]

また、第二の保護膜である窒化シリコン系膜膜厚が 0 . 1 μ m 以上であるため、その下地

である酸化シリコン系膜の水分吸着も防ぐことができる。更に第三の保護膜である酸化チタン系膜および酸化シリコン系膜のそれぞれの膜厚が 0 . 1 μ m 以上であるため、保護膜のピンホール発生率を下げることができるため、信頼性の高い薄膜の固体電池を提供できる。

[0029]

ここからは、(表1)に示す評価方法の説明をする。

[0 0 3 0]

評価方法は試験 1 から試験 3 がある。試験 1 とは評価電池について、1C充電と1C放電を10回繰り返し、その10回目の放電容量の1回目の放電容量に対する割合を求め、値が大きい程サイクル特性が良と判断する評価である。

[0031]

試験 2 とはシリコン基板上に2000、1cm²のアルミ膜を形成し、その上に評価すべき保護膜を形成し、次に70 の燐酸溶液に10分間浸漬後、アルミエッチングされた箇所を顕微鏡にてカウントする方法で、カウント数が少ないほど膜ピンホールが少なく膜質が良と判断する評価である。

[0 0 3 2]

試験 3 とは評価電池について、1C充電と1C放電を200回繰り返し、次に保護膜のクラック発生の有無を顕微鏡にて観察する方法で、電池の充放電による膨張収縮による保護膜のクラック発生を確認して膜強度を見極める評価である。

[0033]

また、固体電解質薄膜材料としては、銀イオン導電性固体電解質、銅イオン導電性固体電解質、リチウムイオン導電性固体電解質、プロトン導電性固体電解質を用いることができる。

[0034]

[0 0 3 5]

【発明の効果】

以上のように本発明の固体電池によれば、ピンホールやクラック発生の無い膜強度に優れた保護膜を有し、かつ電池容量の充放電サイクル劣化が見られな固体電池とすることができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の実施の形態に1おける固体電池の縦断面図
- 【図2】本発明の実施の形態2における固体電池の縦断面図
- 【図3】従来の固体電池の縦断面図

【符号の説明】

- 1 1 シリコン基板
- 1 2 シリコン酸化膜
- 13 金属アルミ膜
- 1 4 正極活物質膜
- 15 固体電解質膜
- 16 負極活物質膜
- 1 7 金属銅膜

30

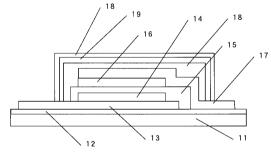
10

20

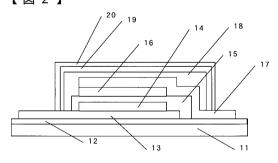
40

- 18 SiO₂ (第1の保護膜)
- 19 Si₃ N₄ (第2の保護膜)
- 20 TiO₂ (第3の保護膜)
- 3 1 基板
- 3 2 正極集電体
- 3 3 正極活物質膜
- 3 4 固体電解質膜
- 3 5 負極活物質膜
- 3 6 負極集電体
- 3 7 窒化シリコン膜

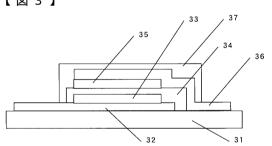
【図1】



【図2】



【図3】



フロントページの続き

F ターム(参考) 5H029 AJ03 AJ05 AK03 AL07 AM12 BJ12 DJ08 EJ03 EJ05 HJ04